

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от "09" октября 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

4 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации **Зиновьева Романа Александровича** на тему «Исследование дефектов в GaN светодиодах», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников».

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» 13.04.2020, протокол №17, с изменением от 10.06.2020 протокол №19.

Диссертация выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС».

Научный руководитель – к.т.н. Поляков Александр Яковлевич профессор, сотрудник кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС».

Экспертная комиссия утверждена Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» (протокол №17 от 13.04.2020, с изменением от 10.06.2020 протокол №19) в составе:

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., доцент, в.н.с. кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» - председатель комиссии;
2. Мурашев Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;
3. Бублик Владимир Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»;
4. Мармалюк Александр Анатольевич – д.т.н., начальник НТЦ АО «НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха»;

5. Редькин Аркадий Николаевич – д.ф.-м.н., заведующий экспериментально-технологической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук.

Ведущее предприятие:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук г. Санкт-Петербург.

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Зиновьева Романа Александровича об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 4
осталось нерозданных бюллетеней 1
оказалось в урне бюллетеней 4

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Зиновьеву Роману Александровичу ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников»:

«за» - 4;
«против» - 0;
недействительных бюллетеней – 0.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/~~невозможности~~ (ненужное вычеркнуть) присуждения Зиновьеву Роману Александровичу ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников».

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Зиновьева Романа Александровича. Заключение комиссии принято единогласно.

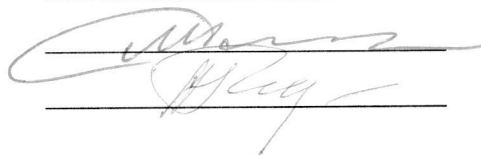
председатель комиссии д.ф.-м.н. Ховайло В.В.

член комиссии д.т.н. Мурашев В.Н.

член комиссии д.ф.-м.н. Бублик В.Т.

член комиссии д.т.н. Мармалюк А.А.

член комиссии д.ф.-м.н. Редькин А.Н.



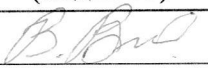
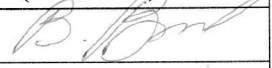
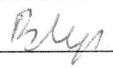
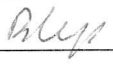
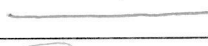
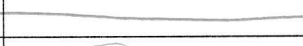
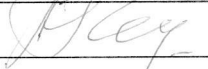
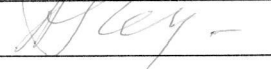
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от 09.10.2020 г.

по защите кандидатской диссертации **Зиновьева Романа Александровича** на тему

«Исследование дефектов в GaN светодиодах»

по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников»

№	Фамилия	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Ховайло Владимир Васильевич		
2	Мурашев Виктор Николаевич		
3	Бублик Владимир Тимофеевич		
4	Мармалюк Александр Анатольевич		
5	Редькин Аркадий Николаевич		

Председатель комиссии, д.ф.-м. н.



Ховайло В.В.